

广东省粤晶高科股份有限公司

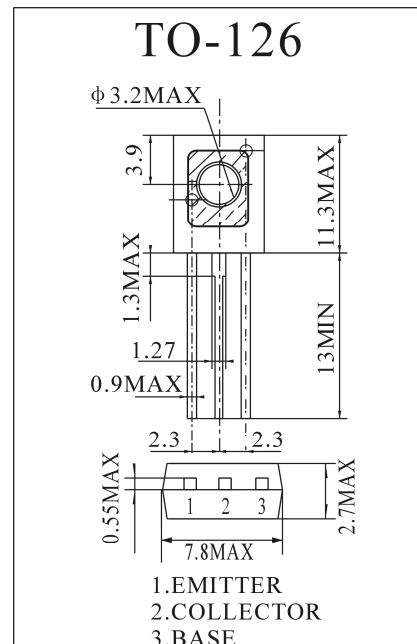
B631K

—PNP silicon—

■■■主要用途：高压、开关、功率放大等。

■■■绝对最大额定值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 项 目 | 符 号 | 额定值 | 单 位 |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|
| 集电极—基极电压 | V_{CBO} | -120 | V |
| 集电极—发射极电压 | V_{CEO} | -120 | V |
| 发射极—基极电压 | V_{EBO} | -5 | V |
| 集电极电流 | I_C | -1 | A |
| 集电极耗散功率 | P_C | 1 | W |
| 集电极耗散功率($T_C=25^\circ\text{C}$) | P_C | 8 | W |
| 结 温 | T_J | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 存储温度 | T_{stg} | -55~150 | $^\circ\text{C}$ |



■■■电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 项 目 | 符 号 | 最 小 值 | 典 型 值 | 最 大 值 | 单 位 | 测 试 条 件 |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|--|
| 直流电流增益 | h_{FE1} | 60 | | 320 | | $V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -50\text{mA}$ |
| | h_{FE2} | 20 | | | | $V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -500\text{mA}$ |
| 集电极-基极截止电流 | I_{CBO} | | | -1 | μA | $V_{CB} = -50\text{V}, I_E = 0$ |
| 发射极-基极截止电流 | I_{EBO} | | | -1 | μA | $V_{EB} = -4\text{V}, I_C = 0$ |
| 集电极-基极击穿电压 | BV_{CBO} | -120 | | | V | $I_C = -0.01\text{mA}, I_E = 0$ |
| 集电极-发射极击穿电压 | BV_{CEO} | -120 | | | V | $I_C = -1\text{mA}, I_B = 0$ |
| 发射极-基极击穿电压 | BV_{EBO} | -5 | | | V | $I_E = -0.01\text{mA}, I_C = 0$ |
| 集电极-发射极饱和压降 | $V_{CE(sat)}$ | | -0.15 | -0.4 | V | $I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$ |
| 基极-发射极饱和压降 | $V_{BE(sat)}$ | | -0.85 | -1.2 | V | $I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$ |
| 电流增益-带宽乘积 | f_T | 50 | 110 | | MHz | $I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}$ |
| 共基极输出电容 | C_{ob} | | 30 | | pF | $V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$ |
| 下降时间 | t_f | | 80 | | ns | $V_{CE} = -12\text{V}, P_w = 20 \mu\text{s}$ $I_c = 10I_{B1} = -10I_{B2} = -500 \text{ mA}$ |
| 关断时间 | t_{off} | | 100 | | ns | |
| 存贮时间 | t_{stg} | | 600 | | ns | |

■■■ h_{FE} 分档及其标志

| 分 档 | D | E | F |
|-----------|--------|---------|---------|
| h_{FE1} | 60~120 | 100~200 | 160~320 |